

Кремниевый фотодетекторный чип 838×838 мкм — техническое описание

P/N : WS9K-10B

Применение

Si NIP фотодиодные чипы

Структура

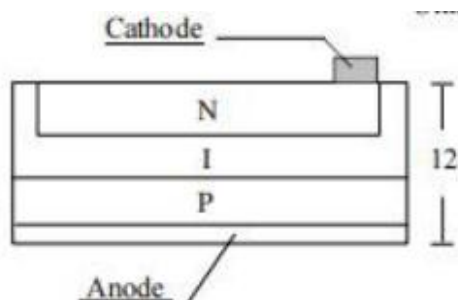
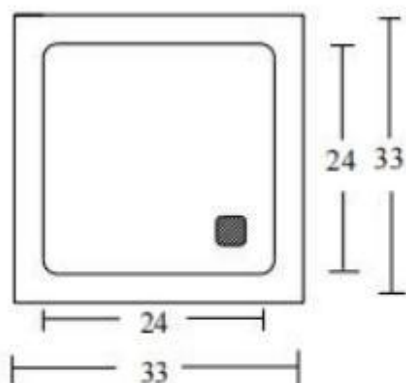
Планарная структура: NIP-диод; электроды: верхняя сторона (катод) — Al, задняя сторона (анод) — сплав Au

ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	24 × 24 (± 1.0)			мил
Ширина чипа	33 × 33 (± 1.5)			мил
Длина чипа	33 × 33 (± 1.5)			мил
Высота чипа	12 ± (1.0)			мил
Контактная площадка катода	5.6 × 5.6			мил
Контактная площадка анода	5.6 × 5.6			мил

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	VF	IF=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	VBR	IR=100μA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	ID	VR=10V, H=0			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λр			940		нм
Емкость	CJ	VR=3V, F=1 MHz		9		пФ



Ед.: мил